

【19】中華民國

【12】發明公開公報 (A)

【11】公開編號：200539134

申請實體審查：有

【43】公開日：中華民國94(2005)年12月1日

【51】國際專利分類 Int. Cl.⁷：G11B5/84

【54】發明名稱：磁性記錄裝置的製造方法

【21】申請案號：093115509

【22】申請日：中華民國93(2004)年5月31日

【72】發明人：賴志煌；楊政翰 YANG, CHENG HAN

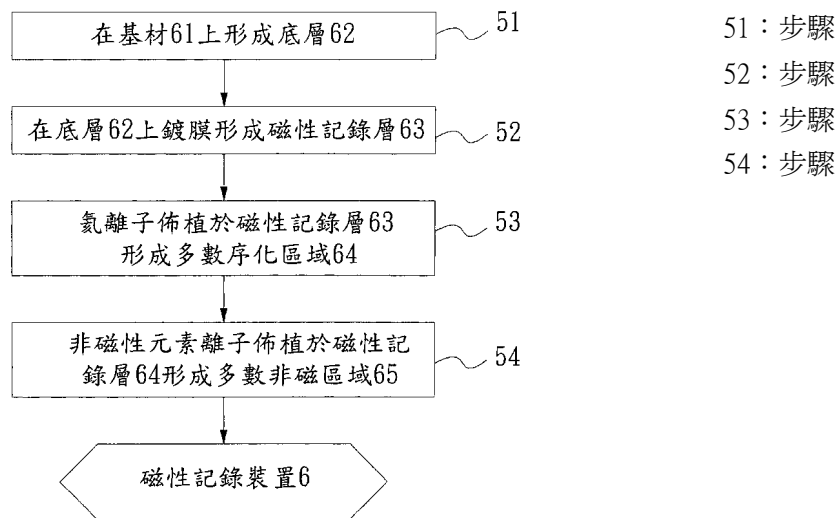
【71】申請人：國立清華大學 NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

新竹市光復路2段101號

【74】代理人：惲軼群；陳文郎

【57】發明摘要

一種磁性記錄裝置的製造方法，是先依序在基材上形成底層與磁性記錄層，再以氮離子佈植於磁性記錄層之一第一區域區域，使第一區域中的多數原子規則排列而成為一序化區域，並同時可以非磁性元素離子佈植於磁性記錄層之一第二區域，使第二區域中成為一非磁區域。本發明以離子佈植之直接能量轉換方式而無須後退火製程，即可使磁性記錄層形成多數間隔排列之非磁區域區與獨立的序化區域，且有效地降低鐵鋁合金之序化溫度，進而增加記錄儲存密度。此外，由於離子束具有可聚焦特性或是結合光罩的方式，可進行記錄媒體規則圖案之直接繪製。



代表圖式